



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 550 802 A1**

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: **92117679.8**

Int. Cl.⁵: **H03B 5/12**

Anmeldetag: **16.10.92**

Priorität: **08.01.92 DE 4200234**

Anmelder: **ROBERT BOSCH GMBH**
Postfach 30 02 20
W-7000 Stuttgart 30(DE)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
14.07.93 Patentblatt 93/28

Erfinder: **Festag, Winfried, Dipl.-Ing.**
Holsteinische Strasse 45
W-1000 Berlin 41(DE)

Benannte Vertragsstaaten:
DE DK FR GB IT NL SE

Rauscharmer Oszillator.

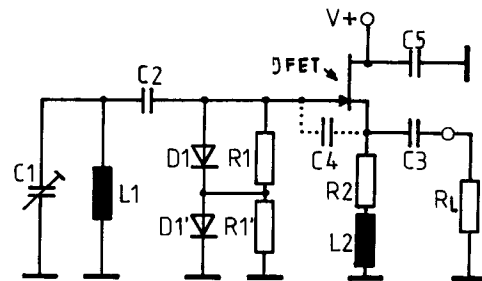
2.1. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfache und universelle Schaltung anzugeben, die auch bei niedrigen Frequenzen ohne die Aufteilung der Schwingkreis Kapazität oder die Anzapfung der Schwingkreisinduktivität auskommt.

2.2. Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß ein aus einem einstellbaren Kondensator (C1) und einer Induktivität (L1) bestehender Schwingkreis über einen Kondensator (C2) und eine aus mindestens einer Schottky-Diode (D1) sowie mindestens einem Widerstand (R1) bestehende Diodenklemmschaltung mit dem Eingang (Gate) eines in Drainschaltung arbeitenden Sperrschicht-Feldeffekttransistors (JFET) großer Steilheit verbunden ist, daß an der Drain-Elektrode des JFET eine positive Betriebsspannung parallel zu einer HF-Abblock-Kapazität (C5) liegt und daß der Ausgang des JFET über einen Widerstand (R2) mit einer Drossel (L2) sowie einem parallel dazu liegenden Kondensator (C3) und einem Widerstand (RL) verbunden ist.

2.3. Ein bevorzugtes Anwendungsgebiet ist der Einsatz in portablen Geräten der Kommunikationstechnik.

3. Die Zeichnung zeigt das Schaltbild des Oszillators.

FIG. 1



EP 0 550 802 A1

Die Erfindung betrifft einen rauscharmen Oszillator, der insbesondere für professionelle portable Geräte der Kommunikationstechnik geeignet ist.

Das Anwendungsgebiet reicht von niedrigen Frequenzen bis in das UHF-Gebiet.

Zur Realisierung der Oszillatoren sind eine Vielzahl von Schaltungen bekannt, z.B. die Colpitts- oder die Hartley-Schaltung. Nachteilig sind hierbei die Aufteilung der Schwingkreis Kapazität zur Rückkopplung bzw. die Anzapfung der Schwingkreisinduktivität zur Realisierung der Phasenbedingung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfache und universelle Schaltung anzugeben, die auch bei niedrigen Frequenzen ohne die Aufteilung der Schwingkreis Kapazität oder die Anzapfung der Schwingkreisinduktivität auskommt.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß die erfindungsgemäße Schaltung wie im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 dargelegt, aufgebaut ist.

Die erfindungsgemäße Schaltung stellt einen mitgekoppelten Verstärker dar; aufgrund des hohen Eingangswiderstandes des JFET genügt die interne Gate-Source-Kapazität zur Rückkopplung, zumindestens im VHF- und UHF-Gebiet. Die Phasenbedingung wird mit dem Kondensator C3 erfüllt, der gleichzeitig zur Auskopplung der HF-Leistung, die typischerweise zwischen -10 und 0 dbm liegt, dient. Der Scheinwiderstand von C3 muß für sicheres Schwingen bei einer Auskopplung an 50Ω in der Größenordnung des Widerstandes R2 liegen, für den ein typischer Wert 470Ω ist. Für Frequenzen unterhalb 100 MHz sollte der Kondensator C4 hinzugefügt werden, da sonst die Ausgangsleistung merklich absinkt, bei gleichzeitiger Erhöhung der Stromaufnahme, die sonst im Mittel bei 1 mA liegt. Da der Schwingkreis selbst bei großen Kapazitätswerten des Kondensators C2 relativ wenig "Leitwert sieht", ist die belastete Güte des Kreises, besonders bei kleinem Wert von C2, entsprechend hoch, was sich in besonders geringem Phasenrauschen äußert. Durch die ebenfalls geringe Parallelkapazität läßt sich der Oszillator außerdem in entsprechend größerem Bereich kapazitiv durchstimmen, bzw. kann für einen vorgegebenen VCO-Abstimmbereich die Ankopplung der Kapazitätsdiode entsprechend lose erfolgen, was für das Phasenrauschverhalten der gesamten Schaltung von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Besonders wichtige Aufgaben haben die beiden Schottky-Dioden D1, D1' zu erfüllen. Besonders bei niedrigeren Frequenzen kann D1' auch entfallen.

Bei hohen Frequenzen sollten Typen mit kleiner Sperrschichtkapazität gewählt werden. Da diese dann aber oft nur 4 V Sperrspannung vertragen, ist eine Aufteilung des Widerstands R1 zur gleichmäßigeren Verteilung der letzteren sinnvoll. Diese Diodenklemmschaltung begrenzt zum einen die po-

sitiven Schwingamplituden und damit die Änderungen der JFET-Sperrschichtkapazität, d.h. die Oberwellen generierende Varaktor-Aktion, was sich günstig auf die Stabilität des Oszillators und das Rauschverhalten auswirkt und in entsprechend großem Oberwellenabstand äußert, zum anderen erzeugt und stabilisiert sie die negative Gatevorspannung, wodurch der geringe Stromverbrauch der Schaltung überhaupt erst möglich wird. Außerdem wirkt sie ausgleichend auf die erheblichen Exemplantstreuungen der JFET-Parameter, so daß auch mit Extremwerten eines Typs die Ausgangsleistung höchstens um +/- 2 dB schwankt.

Die Ausgangsleistung des erfindungsgemäßen Oszillators läßt sich in weitem Bereich durch entsprechende Dimensionierung des Widerstands R2 und des Kondensators C3 einstellen. Die Induktivität L2 wirkt als reine Sperrdrossel für den jeweiligen Frequenzbereich.

Mit der Bemessung von C2 (und auch ggf. mit C4) wird ein Kompromiß zwischen Stromverbrauch und Phasenrauschen getroffen, bei hoher Schwingkreisgüte kann sowohl eine sehr geringe Stromaufnahme als auch ein äußerst geringes Phasenrauschen realisiert werden.

Die Stromaufnahme ist außerdem praktisch unabhängig von der gewählten Betriebsspannung, ein typischer Wert für letztere ist 5 V.

Der erfindungsgemäße VCO zeichnet sich durch geringes Phasenrauschen, geringe Stromaufnahme, Einfachheit der Schaltung und Universalität aus. Die Verwendung preiswerter Standardbauteile ist möglich. Die vorgeschlagene Schaltung erfüllt damit in hervorragender Weise die Forderungen, die heute an professionelle portable Geräte der Kommunikationstechnik gestellt werden. Nachfolgend sollen Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert werden.

Es zeigt

Fig. 1

das Schaltbild des erfindungsgemäßen Oszillators

Fig. 2 und Fig. 3

jeweils ein Beispiel für den 70 cm-Bereich als VCO

Fig. 4

die Einordnung der erfindungsgemäßen Schaltung in Sender und Empfänger im 2 m-Bereich als VCO's

Fig. 5

die Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Schaltung als temperaturkompensierten Quarzoszillator (TCXO)

Fig. 6

Typische Temperaturabhängigkeit des TCXO

In allen Ausführungsbeispielen wird als JFET der Hochstromtyp J 310 eingesetzt.

In Fig. 2 haben die Bauteile der erfindungsgemäßen Schaltung folgende Grobdimensionierung:

L1-Helixkreis Neosid 7 mm mit 7 Windungen und Anzapfung bei 2,5 Windungen,

C1-Typ BB 814/2,

C2 = 4,7 pF, C3 = 0,5 pF, C5 = 220 pF

D1, D1'-Typ BAT 17-04

R1, R1' = 470k Ω , R2 = 68 Ω , L2 = 270 nH.

Innerhalb des Abstimmereiches von kleiner 440 MHz bis größer 480 MHz ($\Delta f > 40$ MHz) ergeben sich bei einer Stromaufnahme von 2 - 3 mA eine Ausgangsleistung von -7 bis -4 dBm an 50 Ω und ein Phasenrauschen kleiner als 120 dBc in 1 Hz in $\Delta f = 20$ kHz.

In Fig. 3 werden für C1, D1, D1', R1, R1' dieselben Bauteile verwendet wie in Fig. 2. L1 ist ein Helixkreis Neosid 7 mm mit 8 Windungen und Anzapfung bei 1,4 Windungen. Bei einer Stromaufnahme von 2,8 bis 5 mA beträgt die Ausgangsleistung -8 bis -4 dBm an 50 Ω , das Phasenrauschen ist kleiner als 120 dBc in 1 Hz in $\Delta f = 20$ kHz. Der Frequenzbereich reicht von 400 bis 520 MHz (Δf 80 bis 100 MHz).

Die Dimensionierung der anderen Bauteile beträgt: C2 = 22 pF, C3 = 0,5 pF, C5 = 220 pF, R2 = 100 Ω , L2 = 270 nH.

Der in Fig. 4 gezeigte Sender/Empfänger-VCO hat für den Sender eine typische Stromaufnahme von 1 mA, für den Empfänger von 0,7 mA. Das Phasenrauschen ist in beiden Fällen kleiner oder gleich 130 dBc in 1 Hz in $\Delta f = 20$ kHz.

Im Sender-VCO haben die Bauteile der erfindungsgemäßen Schaltung folgende Dimensionierung:

C1 = 4,7 pF + einstellbar 1 - 3 pF, C2 = 5,6 pF, C3 = 1,8 pF, C5 = 470 pF, D1, D1'-Typ BAT 17-04, R1, R1' = 220 k Ω , R2 = 470 Ω , RL = 100 Ω . Der Empfänger-VCO enthält für D1, D1', R1, R1', R2, C5 dieselben Bauteile wie der Sender-VCO. Zusätzlich ist hier der Kondensator C4 = 2,2 pF vorgesehen. Darüber hinaus betragen C1 = 10 pF + einstellbar 3 - 8 pF, C2 = 47 pF, C3 = 4,7 pF, RL = 3,3 k Ω .

Fig. 5 zeigt einen temperaturkompensierten Quarzoszillator (TCXO). Im Schwingkreis ist ein Quarz vom Typ KVG nach PV Q 098 angeordnet mit einer Serienresonanzfrequenz von 12,8 MHz \pm 10 PPM und einer Temperaturdrift \pm 7,5 PPM. Zum Zweck der Temperaturkompensation ist parallel zum Quarz der Kondensator C1a = 10 pF geschaltet. C1 ist einstellbar von 3 - 8 pF. Die anderen Bauteile haben eine Dimensionierung von L1 = 6,8 μ H, L2 = 100 μ H, C2 = 82 pF, C3 = 15 pF, C4 = 8,2 pF, D1- Typ BAT 17, R1 = 470 k Ω , R2 = 2,7 k Ω .

Der Oszillator hat eine Stromaufnahme von 0,22 bis 0,37 mA, die Ausgangsspannung an 10 k Ω || 10 pF beträgt 0,6 - 0,9 V_{eff}. Die Temperaturdrift

beläuft sich im Bereich von -25 °C bis +60 °C auf \pm 8 PPM maximal. Der Oberwellenabstand ist größer als 20 dB. Das Phasenrauschen liegt unterhalb der Nachweisgrenze üblicher Meßeinrichtungen. Die typische Temperaturabhängigkeit des TCXO zeigt Fig. 6.

Patentansprüche

1. Rauscharmer Oszillator, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein aus einem einstellbaren Kondensator (C1) und einer Induktivität (L1) bestehender Schwingkreis über einen Kondensator (C2) und eine aus mindestens einer Schottky-Diode (D1) sowie mindestens einem Widerstand (R1) bestehende Diodenklemmschaltung mit dem Eingang (Gate) eines in Drainschaltung arbeitenden Sperrschicht-Feldeffekttransistors (JFET) großer Steilheit verbunden ist, daß an der Drain-Elektrode des JFET eine positive Betriebsspannung parallel zu einer HF-Abblock-Kapazität (C5) liegt und daß der Ausgang des JFET über einen Widerstand (R2) mit einer Drossel(L2) sowie einem parallel dazu liegenden Kondensator (C3) und einem Widerstand(RL) verbunden ist.
2. Rauscharmer Oszillator nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß zwischen Source und Gate des JFET ein Kondensator (C4) geschaltet ist.
3. Rauscharmer Oszillator nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Diode D1 aufgeteilt ist in zwei Dioden D1 und D1' und daß der dazugehörige Widerstand R1 aufgeteilt ist in zwei Widerstände R1 und R1'.

FIG. 1

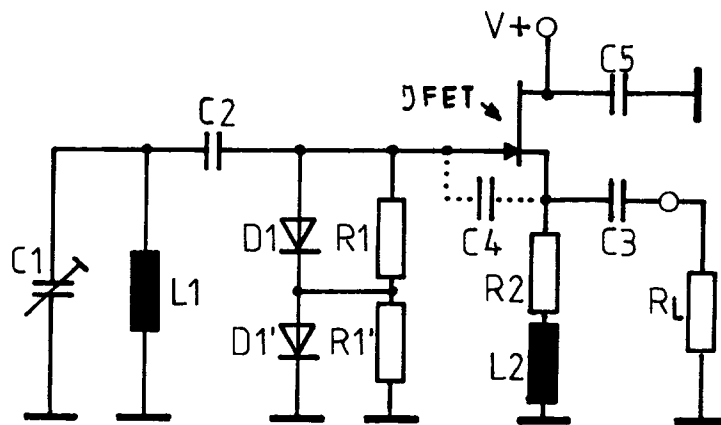


FIG. 2

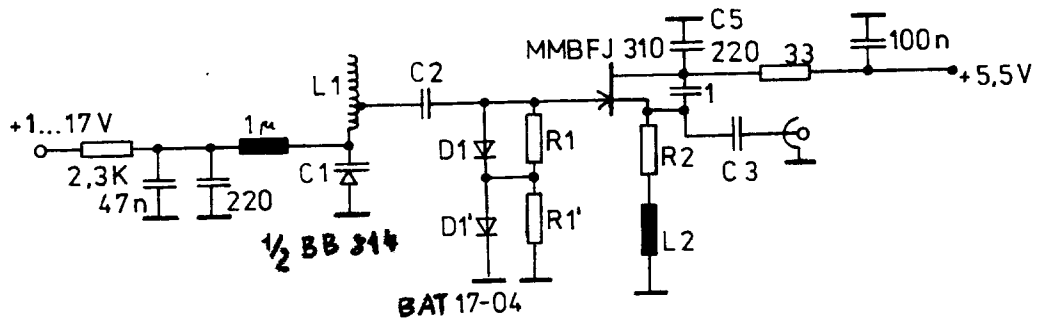


FIG. 3

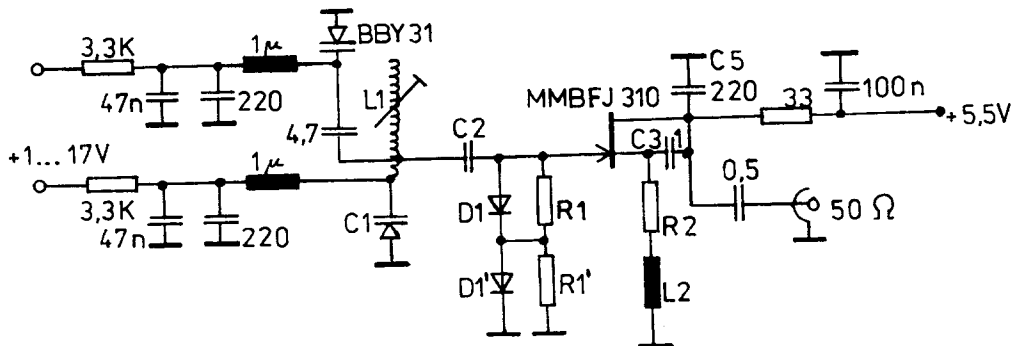


FIG. 4

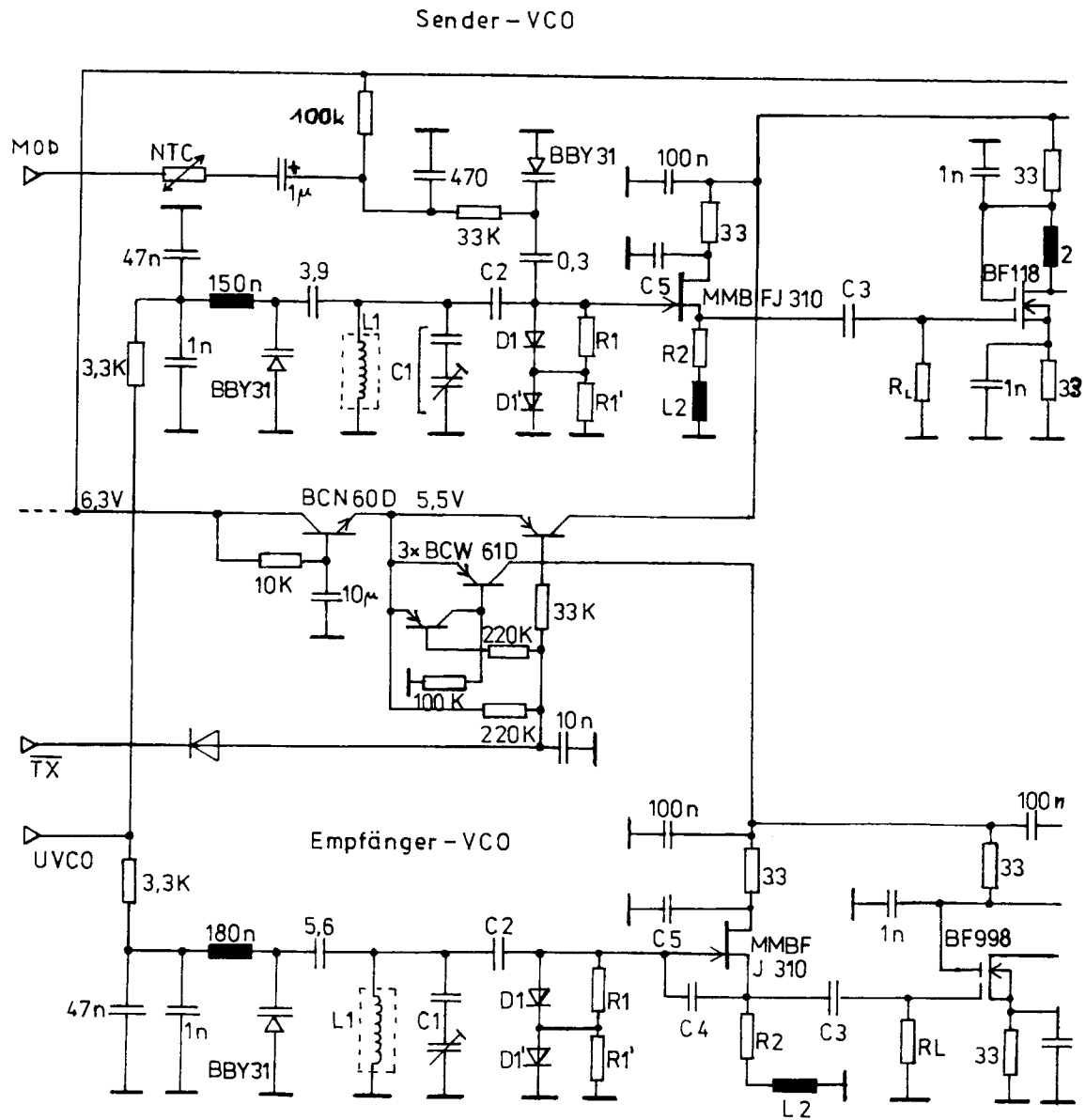


FIG. 5

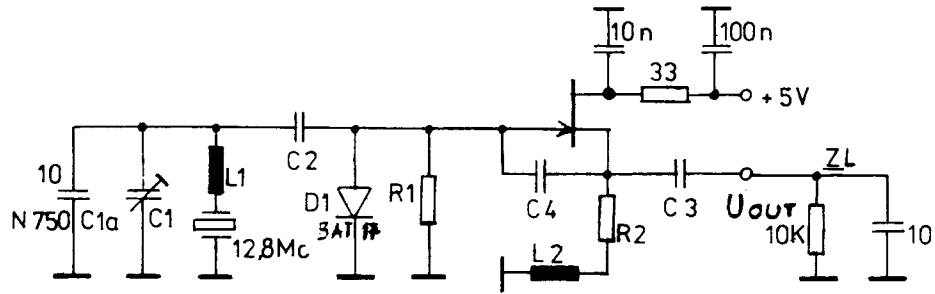
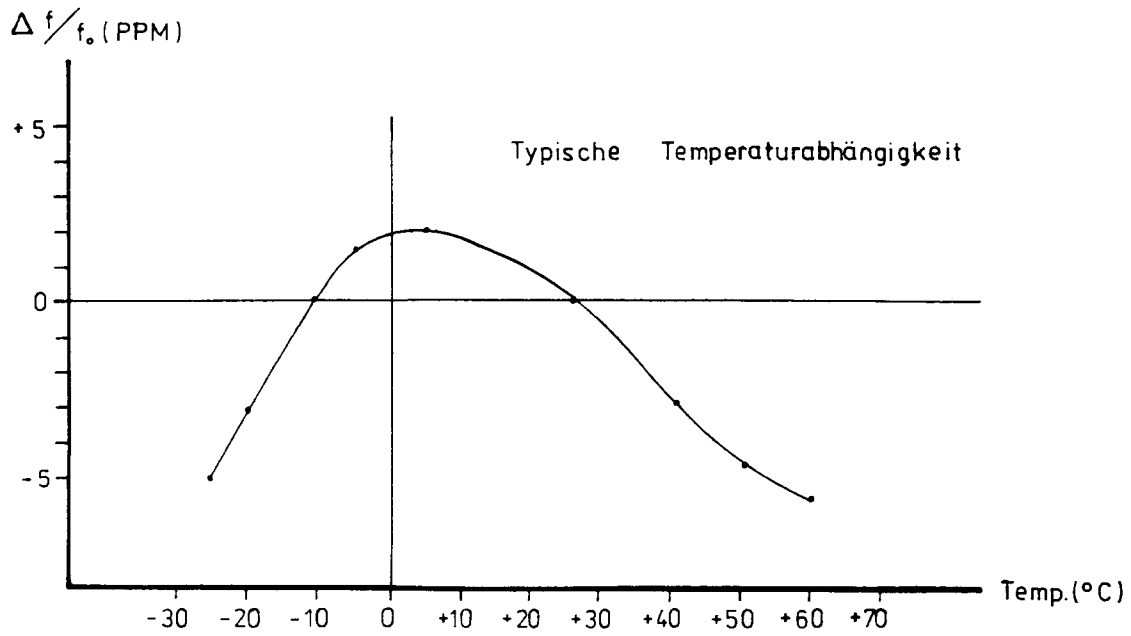


FIG. 6





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 11 7679

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	US-A-4 785 264 (KALTENECKER ET AL.) * Spalte 1, Zeile 41 - Spalte 2, Zeile 23 *	1-3	H03B5/12
A	DE-A-2 721 406 (LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH) * Anspruch 1; Abbildung 1B *	1-3	
A	RADIO COMMUNICATION Bd. 52, Nr. 5, Mai 1976, LONDON,GB Seiten 359 - 360 . 'The goral oscillator' * Abbildung 8 *	1-3	
A	ELECTRONICS & WIRELESS WORLD Bd. 93, Nr. 1617, Juli 1987, SURREY GB Seiten 707 - 709 A. DEKKER: 'Universal voltage-controlled oscillator with low phase noise.' * Abbildung 4 *	1-3	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			H03B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 15 APRIL 1993	Prüfer PEETERS M.M.G.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patendokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P0403)